IR Transmitter & Receiver

משדר ומקלט אינפרא אדום

מטרות הניסוי

- 1. הכרת עקרונות העברת המידע באמצעות אור אינפרא אדום
- QED233 אינפרא אדום מסוג LED 23. תכנון משדר ומקלט באמצעות דיודת QSE973. ופוטודיודה מסוג
 - הפעלת המערכת תקשורת ובדיקת פעילותה.

שאלות הכנה:

1. רקע עיוני מפורט לניסוי:

טכנולוגיית IR

אינפרא-אדום היא קרינה אלקטרומגנטית שאורך הגל שלה ארוך מאשר האור הנראה לעין, הכוונה היא שטווח האור שאנחנו מסוגלים לראות הוא רק חלק קטן מתוך ספקטרום עצום של גלים אלקטרו-מגנטים קצרים וארוכים. גלים קצרים הם קרני רנטגן וקרני גמא עטורות אנרגיה, גלים ארוכים הם גלי רדיו ומיקרוגל.

את טכנולוגיית ה-IR גילה אסטרונום בשם ויליאם הרשל, כשביצע ניסוי בו הצמיד מדחום כספית למנסרה. בעת שניסה למדוד את טמפרטורת הצבעים שנשברת במנסרה, גילה שמעבר לצבע האדום שנשבר במנסרה, גם עלתה טמפרטורת המדחום באופן קיצוני.

אור אינפרא-אדום מתחלק ל-3 סוגים: אינפרא-אדום קרוב, אינפרא-אדום בינוני ואינפרא-אדום טרמי (ארוך).

- 700-1300[nm] איפרא-אדום קרוב נע בטווח של •
- 1300-3000[nm] אינפרא-אדום בינוני נע בטווח של
- 3000-30000[nm] אינפרא-אדום טרמי נע בטווח של

אור אינפרא-אדום קרוב ובינוני מוחזרים מעצמים ממש כמו אור נראה, המופק מהשמש. לעומתם, אור אינפרא-אדום טרמי מופק על ידי עצמים חמים ומקורות חום שונים.

משדר ומקלט IR

משדר - עוצמת השידור תלויה בעוצמת האור שדיודת ה- IR פולטת. עוצמת האור שהדיודה פולטת תלויה בעוצמת הזרם דרך נגד. לכן, אם אנו רוצים להגדיל את מרחק השידור עלינו להגדיל את הזרם דרך הנגד (ע"י הקטנת הנגד, אך צריך להיזהר לא לגרום לזרם גבוה מדי שיפגע במשדר).

מקלט - כאשר האור אינפרא אדום פוגע במקלט, המקלט נכנס להולכה ומזרים זרם דרכו כך שמתפתח מתח גדול על פני הנגד.

כאשר אור אינפרא אדום אינו פוגע במקלט, המקלט נכנס לקיטעון ואינו מזרים זרם דרכו כך שלא מתפתח מתח על פני הנגד.

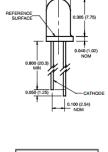
שימושים במשדר-מקלט מסוג IR

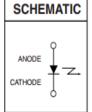
קרינת IR משמשת, למשל: מדידת מרחק, תקשורת אופטית (אות אינפרא אדום העובר דרך סיבים אופטיים). לקרינת ה-IR שימוש גם בצבא, ראיית לילה, הנחייה (כלי נשק שונים שמונחים ב-IR).

דיודת IR

דיודת IR הוא רכיב הפולט קרינה בתדר IR למרחק של בין מספר ס"מ ולספר מטרים, זהו הרכיב המרכזי במעגל המשדר שנבנה.

דיודת IR מתנהגת כמו דיודה רגילה – צורכת 100mA ו-1.6V אבל בשונה מדיודה רגילה, דיודת IR בנויה כך שישנו פער אנרגטי ישיר בין נקודת השיא האנרגטית בפס הערכיות, לבין השפל האנרגטי בפס ההולכה של המוליך למחצה. משמעות הפער האנרגטי הישיר היא שהאלקטרון יכול ליפול מפס ההולכה לפס הערכיות תוך שימור התנע שלו ופליטת פוטון בעל אנרגיה המתאימה לפער זה, כלומר הדיודה תפלוט אור כאשר היא נמצאת בממתח קדמי. לכל חומר יש פער אנרגטי שונה ולפי זה נקבע צבע האור שנפלט מהמוליך למחצה. כאשר הדיודה בהולכה היא פולטת קרינה שאותה ניתן אחר כך לקלוט בדיודה קולטת אור. יתרונות השימוש בדיודת IR הוא שהספקטרום הנפלט ממנה הוא צר פס ולכן אין צורך במסננים נוספים על מנת לקבל ספקטרום ספציפי.

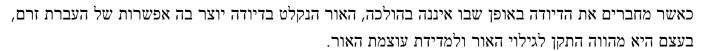




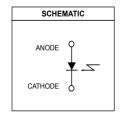
.126 (3.20) .110 (2.80)

פוטו-דיודה

הפוטו-דיודה היא דיודה המשמשת כגלאי אור והיא הופכת את האור לזרם חשמלי שנותן לנו אינדיקציה לעוצמת האור שנקלטה. ברגע שפוגע האור בדיודה, האור מעורר את האלקטרונים שעוברים מריכוז גבוהה של אלקטרונים לריכוז הנמוך, ויוצרים זרם הנקרא זרם דיפוזיה. מעבר של אלקטרונים מהווה אינדיקציה לעוצמת האור.



בניסוי שלנו נשתמש בפוטו-דיודה מסוג QSE973.



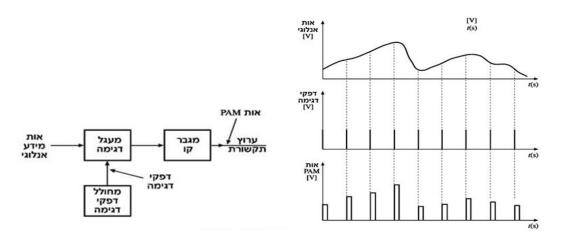
פוטוטרנזיסטור

טרנזיסטור רגיש לאור אינפרא-אדום. כאשר בטרנזיסטור זה פוגע אור בתחום אורכי גל אינפרא-אדום אליהם הוא רגיש, הוא נכנס לרוויה ובין הקולקטור לאמיטר יהיה מתח של 0.1V. כאשר בטרנזיסטור לא פוגע אור או שפוגע אור בתחום אורכי הגל שהוא אינו רגיש אליהם, הוא ייכנס לקיטעון. במקרה זה יהיה בין הקולקטור לאמיטר מתח של 5V. לפי מתח זה נוכל לדעת אם הוא קולט אור אינפרא אדום או לא.



אפנון תנופת הדופק): PAM – Pulse Amplitude Modulation אפנון

אפנון PAM – אפנון אמפליטודה בעזרת פולסים. גודל התנופה הינו ערך האות האנלוגי בנקודת הדגימה. בשיטה זו משדרים בערוץ אות קצר (כאורך הדגימה) בעוצמת האות המקורי. מגבר הקו מגביר את הדפקים המתקבלים אחרי הדגימה, ומשדר אותם לערוץ התקשורת תנופת הדפקים שווה לרמתו של האות האנלוגי בזמן הדגימה - רוחב הדפקים קבוע ומוגדר מראש.



בעיות אפשריות באפנון זה:

- תנופת האות לאחר השידור מושפעת מרעשים בתווך, השהיות ועיוותים.
- בפעולת השחזור ניתן להתייחס רק לתנופת האות ולכן ייתכנו טעויות בזיהוי הרמה האמיתית של האות.
 - . אילו ידענו את מרחק השידור יכולנו לקזז חלק מהעיוותים אך מידע זה לא קיים.
 - טעות בזיהוי רמת המתח המקורי (דגימה שאינה נקודתית).
 - סנכרון בערוץ.
 - פתרון: לשדר את השעון בערוץ נפרד 🔾
 - ס פתרון יקר

PAM		
AM	שיטה אנלוגית דומה	
ד קיים עיוות וניחות של תנופת	ההשפעה של מרחק השידו	
האות בתלות במרחק	על צורת האות המשוחזר	דופק משודר ל תנופה [V]
יש השפעה על תנופת האות	השפעת רעשים והפרעות	תצורת הדופק אחרי ק"מ אחד
כל תחנה מוסיפה לעיוות האות המשודר	ההשפעה של כמות תחנות המעבר (מרכזיות וממסרים) על האות המשוחזר	תצורת הדופק אחרי 3 ק"מ תצורת הדופק אחרי 5 ק"מ
על נוצרת טעות מסוימת כתוצאה משחזור לא מדויק של האות בין הדגימות	ההשפעה של עיבוד האות נ צורת האות המשוחזר	
ניתן להסתנכרן על-ידי שידור השעון בערוץ נפרד	סנכרון בין מקלט למשדר	ו/s א. שינוי תצורת דופק בתלות במרחק השידור (ללא רעשים)

האות הנושא בשיטת אפנון זו הוא גל ריבועי, אותו נממש בעזרת רכיב 555 בתצורת מחולל גל ריבועי, כאשר אות המידע הוא למעשה זה שקובע את גובה אמפליטודת הפולסים. נשתמש בטרנזיסטור כמתג על מנת לדגום פולסים של

גל הנושא באמפיליטודת גל המידע ונקבל את משרעת אות המידע בזמן הדגימה. לצורך שחזור המידע יש להשתמש בתדר דגימה הגדול פי 2 מתדר אות המידע (לפי נייקויסט).

2. מעגלי הניסוי וסימולציות:

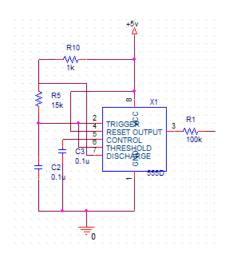
<u>תכנון המשדר:</u>

אפנן PAM

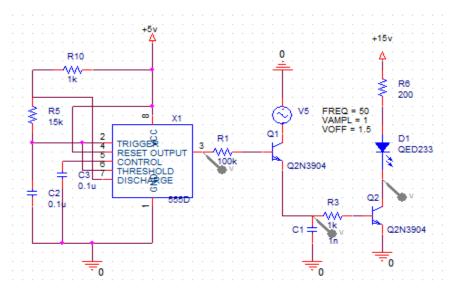
למציאת תדר הגל הנושא, אות ה-IR:

$$T_1 = 0.69R_2C_1 = 1.035ms$$

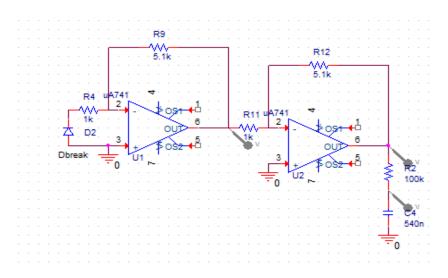
 $T_2 = 0.69(R_2 + R_1)C_1 = 1.104ms$
 $T_{total} = T_1 + T_2 = 2.139ms$
 $f_c = \frac{1}{T_{total}} \cong 467[Hz]$



<u>המשדר:</u>



תכנון המקלט:



. המקלט מורכב מ-2 דרגות הגבר ומגלאי מעטפת

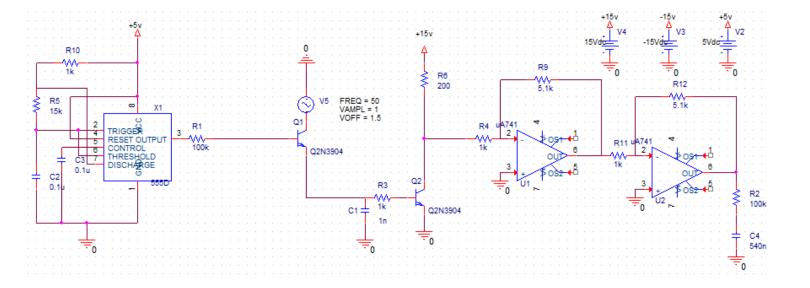
תפקיד המגברים הוא להגביר את אות הכניסה מכיוון שהאות הנקלט הוא אות חלש כתוצאה מרעשים בעת העברת המידע

תפקיד ה-LPF הוא להסיר את האות המאופנן על מנת לשחזר את אות המידע.

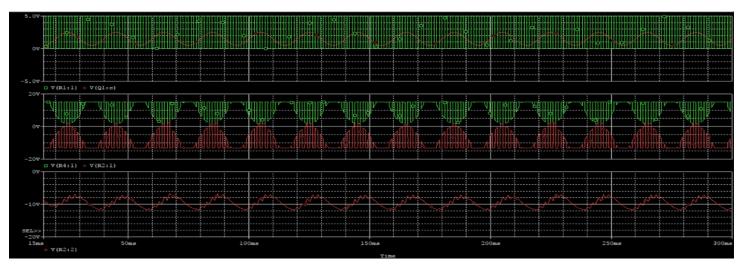
 $RC = 100k \cdot 540n = 5.4ms$ את קבוע הזמן τ של הגלאי:

חיבור מעגל המשדר מקלט:

:סימולציה



להלן תוצאות הסימולציה:

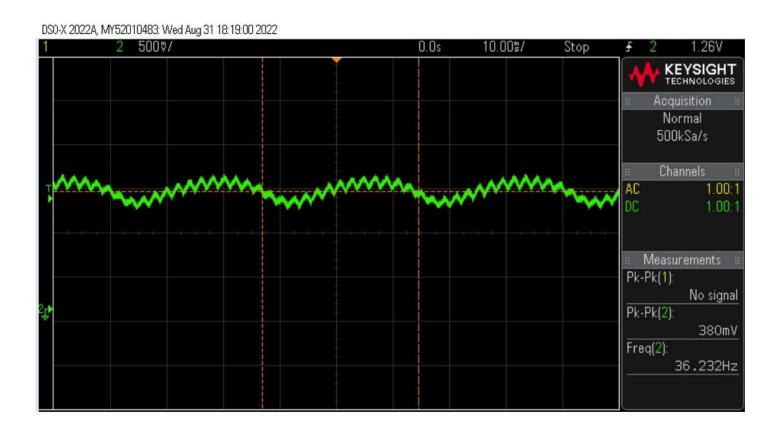


3. רשימת הרכיבים:

- משקף התנודות
- מחולל האותות
- ספק כוח כפול
 - 555 רכיב •
- 2*2N3904 טרנזיסטור •
- 200Ω,1kΩ*3, 5.1kΩ*2,10kΩ,15kΩ,100kΩ : נגדים
 - 1nF,100nF*3:קבלים
 - QED233 מסוג IR דיודת •
 - QSE973 פוטו-דיודה מסוג
 - מגברי שרת מסוג 2*741•
 - 100kΩ פוטנציומטר •

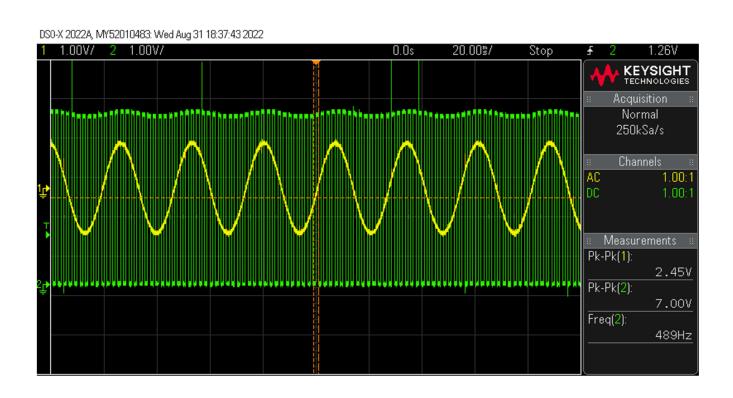
מהלך הניסוי:

1. נבנה את המעגל אשר תכננו בשאלות ההכנה כנדרש, להלן האות המתקבל במקלט: **הערה – חיברנו פוטנציומטר במקום הנגד R2 במוצא המגבר השני שהתנגדותו היא [46.6[kΩ]



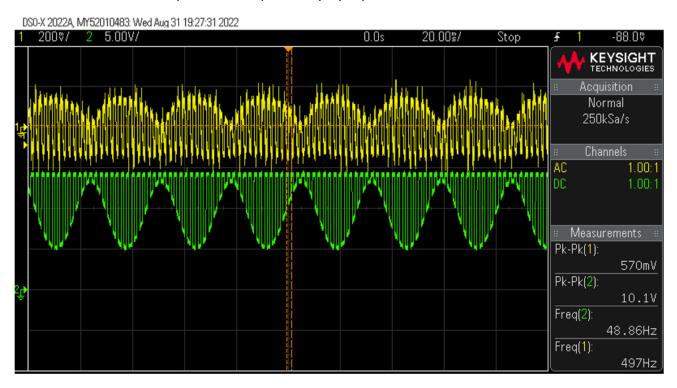
2. נבדוק את צורת הגלים והספקטרומים המתקבלים בנק' החשובות:

ירוק – רגל 3 ברכיב 555, צהוב - קולקטור Q1.

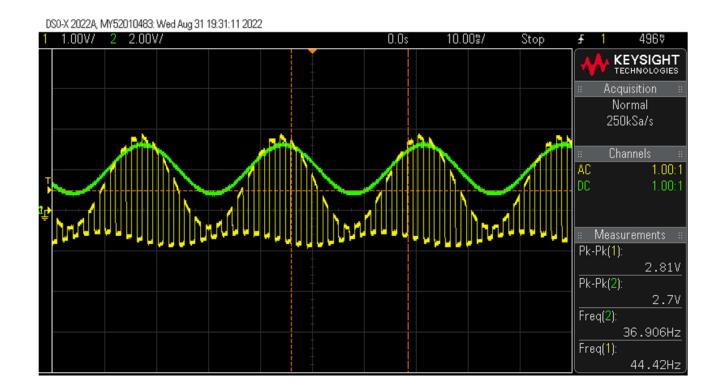




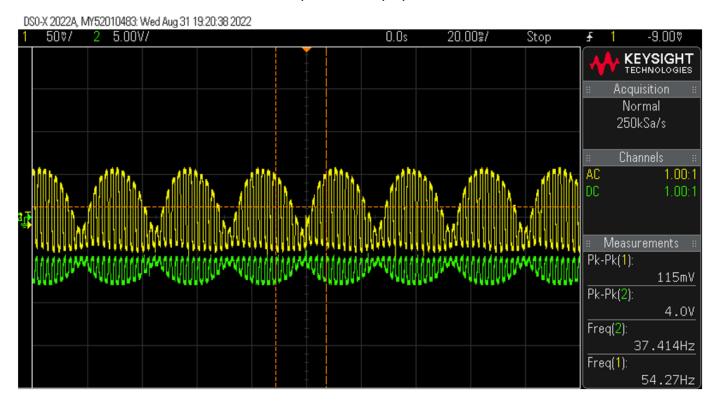
צהוב - אמיטר Q1, ירוק - קולקטור Q2 (מוצא המשדר).



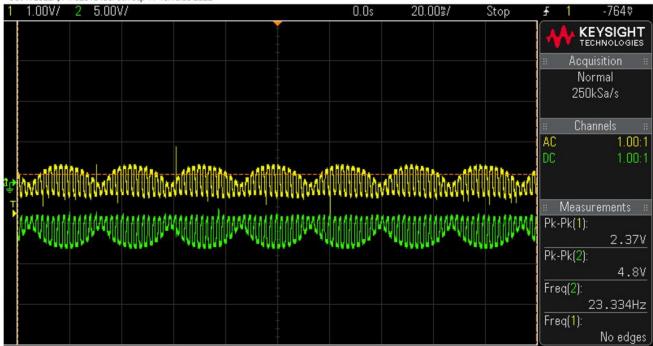
צהוב - קולקטור Q2 (מוצא המשדר), ירוק - כניסת המקלט.



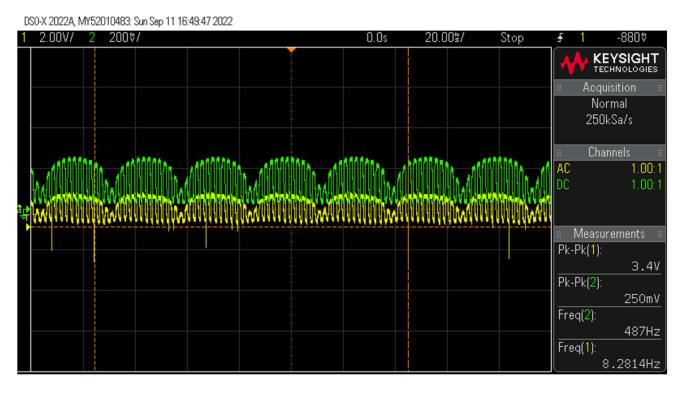
צהוב - קולקטור Q1, ירוק - אימיטר Q1.



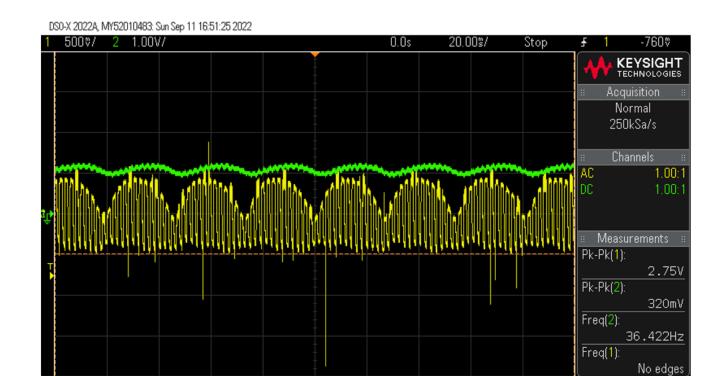
צהוב - כניסת המקלט, ירוק - מוצא מגבר 1 (רגל 6).



עהוב - מוצא מגבר 1 (רגל 6), ירוק - מוצא מגבר 2 (רגל 6)

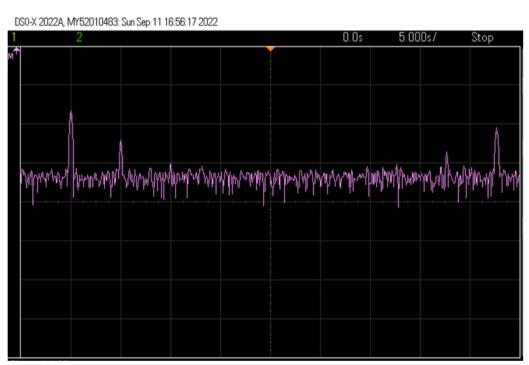


צהוב - כניסת המקלט, ירוק - מוצא מגבר 2 (רגל 6)

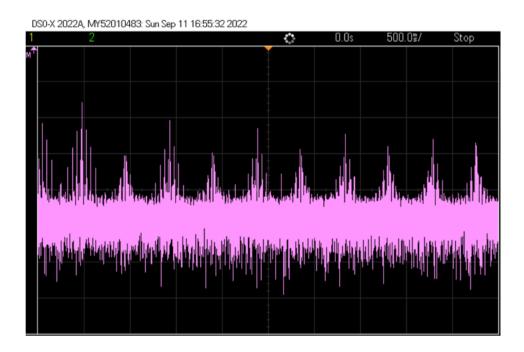


.C4- ל R2 ל-R2 בהוב - מוצא מגבר (רגל 6), ירוק - גלאי המעטפת בין

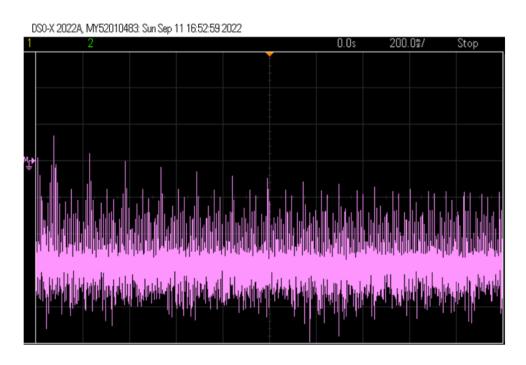
ספקטרום מוצא הגלאי:



: ספקטרום במבוא המקלט



ספקטרום במוצא המשדר:



3. בשלב זה, נבדוק את מרחק השידור המרבי, מרחק השידור המרבי המתקבל הוא בקירוב 16 ס"מ.

התוצאה מאשרת לנו כי המעגל עובד ואכן היה שידור וגילוי של אות אינפרה-אדום, ידוע גם שאות אינפרה-אדום נשלח למרחקים קצרים ולכן זהו המרחק המקסימלי שקיבלנו בתנאים שהיו לנו.

4. בשלב זה, נבצע מס' מדידות של תדר אות המידע המשודר והנקלט בהתאם, להלן טבלת התוצאות: (טבלה 1)

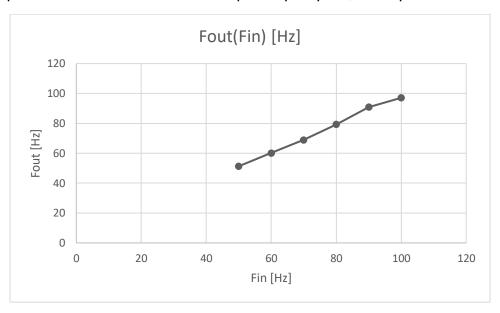
Fin [Hz]	Fout [Hz]
50	51.3
60	60.2
70	68.9
80	79.3
90	90.9
100	97.1

5. נבצע מס' מדידות של אמפליטודות אות המידע המשודר והנקלט בהתאם, להלן טבלת התוצאות: (טבלה 2)

Vin [Vp-p]	Vout [Vp-p]
1	1.06
1.5	1.36
2	1.77
2.5	1.92
3.5	2.02
5	2.13

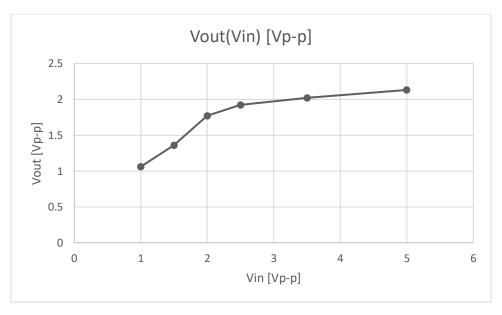
<u>סיכום הניסוי:</u>

טבלה 1: לפי נתוני טבלה 1 ממהלך הניסוי, להלן הגרף המתקבל של תדר אות המידע המשודר והנקלט בהתאם:



ישנו קשר לינארי בין תדר המוצא לתדר הכניסה בתחום הנבדק, כך שתדר המוצא המתקבל קרוב לערך הרצוי עם סטייה קטנה, לבסוף, ניתן לומר כי ישנו גילוי טוב של האות המשודר והקליטה אמינה יחסית.

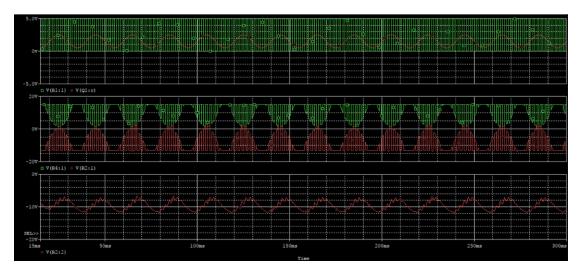
<u>טבלה 2:</u> לפי נתוני טבלה 2 ממהלך הניסוי, להלן הגרף המתקבל של אמפליטודות אות המידע המשודר והנקלט בהתאם:



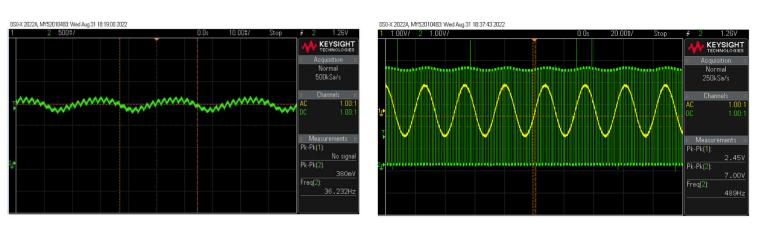
ככל שמתח הכניסה גדל כך גם מתח המוצא, בניגוד לגרף התדר אשר ישנה עלייה והתנהגות לינארית, כאן העלייה לא לינארית.

השוואה בין תוצאות המדידה לסימולציה:

להלן תוצאות הסימולציה:



להלן תוצאות המדידות המתאימות:



תוצאות המדידות שהתקבלו דומות מאוד לתוצאות הסימולציה, הסטייה נובעת מחוסר אידיאליות של הרכיבים וציוד המעבדה, בתמונה העליונה (מלמעלה למטה) בסימולציה רואים את האפנון PAM שהתקבל מרכיב 555 וגל הסינוס בכניסה לטרנזיסטור Q1 (צהוב), קיבלנו תוצאות כמעט זהות במדידות כפי שניתן לראות בתמונה הימנית. הגילוי בסימולציה בתמונה השלישית, גם נראה כמעט זהה לגילוי שהתקבל במדידות. ניתן לסכם ולומר כי התקבלו תוצאות טובות וכי תכנון ויישום המעגל היה מוצלח.

<u>מסקנות:</u>

לפי תוצאות הניסוי, הרכיב 555 ייצר לנו אות באפנון PAM כפי שתכננו, אולם היה חוסר דיוק בין תדר הגל הנושא . $f_c = 487[Hz]$ שתוכנן $f_c = 467[Hz]$

שאר המעגל עבד בדיוק כמו שתכננו והתוצאות המתקבלות דומות מאוד לסימולציה, הסטיות נובעות מאי דיוק הרכיבים, שינוי רכיבים במעגל שתוכנן עקב חוסר ברכיבים וציוד המעבדה.

ביבליוגרפיה:

- https://books.google.co.il/books?id=O5NKqzSh7IMC&pg=PA422&lpg=PA422&dq=%D7%93% D7%99%D7%95%D7%93%D7%AA+%D7%90%D7%99%D7%A0%D7%A4%D7%A8%D7%90 +%D7%90%D7%93%D7%95%D7%9D&source=bl&ots=xlzDjeae7q&sig=syhiJHfuFhuJfHv3Glt I4WE-
- MeE&hl=iw&sa=X&ved=0ahUKEwjf1bjL7oHWAhUE1xQKHashAfcQ6AEISTAI#v=onepage&q&f=false
- - http://school.kotar.cet.ac.il/KotarApp/Viewer.aspx?nBookID=93204598#10.2740.8.fitwidth

LM555

:LM555











SNAS548D - FEBRUARY 2000 - REVISED JANUARY 2015.



LM555 Timer

1 Features

- Direct Replacement for SE555/NE555
- · Timing from Microseconds through Hours
- Operates in Both Astable and Monostable Modes
- Adjustable Duty Cycle
- Output Can Source or Sink 200 mA
- Output and Supply TTL Compatible
- Temperature Stability Better than 0.005% per *C
- Normality On and Normality Off Output
- Available in 8-pin VSSOP Package

2 Applications

- Precision Timing
- Pulse Generation
- Sequential Timing
- Time Delay Generation
- Pulse Width Modulation
- Pulse Position Modulation
- Linear Ramp Generator

3 Description

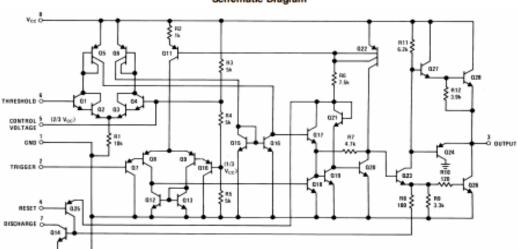
The LM555 is a highly stable device for generating accurate time delays or oscillation. Additional terminats are provided for triggering or resetting if desired. In the time delay mode of operation, the time is precisely controlled by one external resistor and capacitor. For a stable operation as an oscillator, the free running frequency and duty cycle are accurately controlled with two external resistors and one capacitor. The circuit may be triggered and reset on falling waveforms, and the output circuit can source or sink up to 200 mA or drive TTL circuits.

Device Information(1)

PART NUMBER	PACKAGE	BODY SIZE (NOM)
LM555	SOIC (8)	4.90 mm × 3.91 mm
	PDIP (8)	9.81 mm × 6.35 mm
	VSSOP (8)	3.00 mm × 3.00 mm

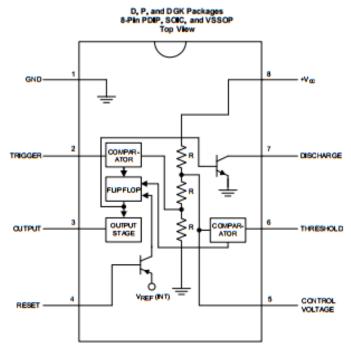
For all available packages, see the orderable addendum at the end of the datasheet.

Schematic Diagram





5 Pin Configuration and Functions



Pin Functions

	PIN		are company
NO.	NAME	NO.	DESCRIPTION
5	Control Voltage	-	Controls the threshold and trigger levels. It determines the pulse width of the output waveform. An external voltage applied to this pin can also be used to modulate the output waveform
7	Discharge	-	Open collector output which discharges a capacitor between intervals (in phase with output). It toggles the output from high to low when voltage reaches 2/3 of the supply voltage
1	GND	0	Ground reference vidtage
3	Output	0	Output driven waveform
4	Reset	•	Negative pulse applied to this pin to disable or reset the timer. When not used for reset purposes, it should be connected to VCC to avoid false triggering
6	Threshold	- 1	Compares the voltage applied to the terminal with a reference voltage of 2/3 Voc. The amplitude of voltage applied to this terminal is responsible for the set state of the flip-flip
2	Trigger	1	Responsible for transition of the flip-flop from set to reset. The output of the timer depends on the amplitude of the external trigger pulse applied to this pin
8	V*		Supply voltage with respect to GND

Submit Documentation Feedback



6 Specifications

6.1 Absolute Maximum Ratings

over operating free-air temperature range (unless otherwise noted)(1)(2)

				MAX	UNIT
Power Dissipation ⁽³⁾ LM555CM, LM555CN ⁽⁴⁾ LM555CMM		LM555CM, LM555CN ⁽⁴⁾		1180	mW/
			613	mW	
	PDIP Package	Soldering (10 Seconds)		260	ç
Soldering Information	Small Outline Packages (SOIC and	Vapor Phase (60 Seconds)		215	ç
	VSSOP) Infrared (15 Seconds)		220	ç	
Storage tempera	Storage temperature, T _{sto}			150	å

Stresses beyond those listed under Absolute Maximum Ratings may cause permanent damage to the device. These are stress ratings only, which do not imply functional operation of the device at these or any other conditions beyond those indicated under Recommended Operating Conditions. Exposure to absolute-maximum-rated conditions for extended periods may affect device reliability.
 If Military/Aerospace specified devices are required, please contact the TI Sales Office/Distributors for availability and specifications.
 For operating at elevated temperatures the device must be derated above 25°C based on a 150°C maximum junction temperature and a thermal resistance of 106°C/W (PDIP), 170°C/W (S0IC-8), and 204°C/W (VSSOP) junction to ambient.
 Refer to RETS555X drawing of military LM555H and LM555J versions for specifications.

6.2 ESD Ratings

			VALUE	UNIT
Vieso	Electrostatic discharge	Human-body model (HBM), per ANSWESDAJJEDEC JS-001(1)	±500 ⁽²⁾	V

JEDEC document JEP155 states that 500-V HBM allows safe manufacturing with a standard ESD control process. The ESD information listed is for the SOIC package.

6.3 Recommended Operating Conditions

over operating free-air temperature range (unless otherwise noted)

	MIN	MAX	UNIT
Supply Voltage		18	>
Temperature, T _A	0	70	ç
Operating junction temperature, T _J		70	ç

6.4 Thermal Information

THERMAL METRIC (1)	PDIP SOIC VSSOP			UNIT
		8 PINS		
R _{6A} Junction-to-ambient thermal resistance	106	170	204	*CW

(1) For more information about traditional and new thermal metrics, see the IC Package Thermal Metrics application report, SPRA953.

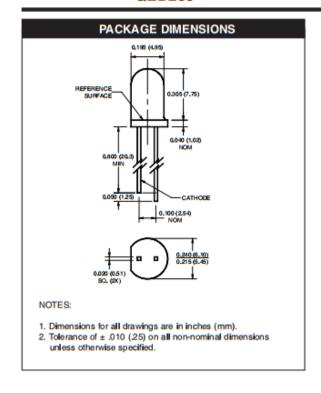
Submit Documentation Feedback

Copyright © 2000–2015, Texa's Instruments Incorporated

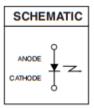


PLASTIC INFRARED LIGHT EMITTING DIODE

QED233 QED234







DESCRIPTION

The QED233 / QED234 is a 940 nm GaAs / AlGaAs LED encapsulated in a clear untinted, plastic T-1 3/4 package.

FEATURES

- \u03b1 = 940 nm
- Chip material =GaAs with AlGaAs window
- Package type: T-1 3/4 (5mm lens diameter)
- Matched Photosensor: QSD122/123/124
- Medium Emission Angle, 40°
- · High Output Power
- · Package material and color: Clear, untinted, plastic
- · Ideal for remote control applications



PLASTIC INFRARED LIGHT EMITTING DIODE

QED234 QED233

ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS (T _A = 25°C unless otherwise specified)							
Parameter Symbol Rating Unit							
Operating Temperature	T _{OPR}	-40 to +100	°C				
Storage Temperature	T _{STG}	-40 to +100	°C				
Soldering Temperature (Iron)(2,3,4)	T _{SOL4}	240 for 5 sec	°C				
Soldering Temperature (Flow) (2.3)	T _{SOL-F}	260 for 10 sec	°C				
Continuous Forward Current	l _F	100	mA				
Reverse Voltage	V _R	5	V				
Power Dissipation(1)	P _D	200	mW				
Peak Forward Current	l _{FP}	1.5	A				

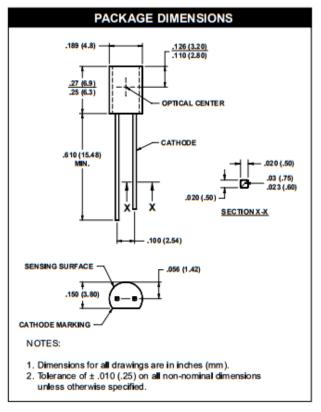
- 1. Derate power dissipation linearly 2.67 mW/°C above 25°C.
- 2. RMA flux is recommended.
- 3. Methanol or isopropyl alcohols are recommended as cleaning agents.
- Soldering iron 1/16" (1.6mm) minimum from housing.
 Pulse conditions; tp = 100 μs, T = 10 ms.

ELECTRICAL / OPTICAL CHARACTERISTICS (TA =25°C)							
PARAMETER	TEST CONDITIONS	DEVICE	SYMBOL	MIN	TYP	MAX	UNITS
Peak Emission Wavelength	l ₌ = 20 mA	ALL	λ _{PE}	_	940	_	nm
Spectral Bandwidth	l _F = 20 mA	ALL	_	50	_	nm	
Temp. Coefficient of λ _{PE}	I _F = 100 mA	ALL	TC _λ	_	0.2	_	nm/K
Emission Angle	I _F = 100 mA	ALL	201/ ₂	_	40	_	Deg.
Forward Voltage	I _F = 100 mA, tp = 20 ms	ALL	V _F	_	_	1.6	V
Temp. Coefficient of V _F	I _F = 100 mA	ALL	TC _V	_	-1.5	_	mV/K
Reverse Current	V _R = 5 V	ALL	I _R	_	_	10	μΑ
Radiant Intensity	I _E = 100 mA, to = 20 ms	QED233	l _E	10	_	50	mW/sr
recent interesty	ip - 100 1151, \$\psi = 20 1115	QED234	'E	27	_	_	
Temp. Coefficient of le	Ļ = 20 mA	ALL	TCı	_	-0.6	_	%/K
Rise Time	I _E = 100 mA	ALL	t,	_	1000	_	ns
Fall Time	ip = 100 IIIA	ALL	t _e	_	1000	_	"

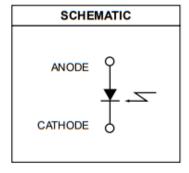


SIDELOOKER PIN PHOTODIODE

QSE973







DESCRIPTION

The QSE973 is a silicon PIN photodiode encapsulated in an infrared transparent, black, plastic T092 package.

FEATURES

- · Daylight filter
- T092 package
- · PIN photodiode
- Recepting angle 90°
- Chip size = .1072 sq. inches (2.712 sq. mm)